

\*\* 公 告 特 許 目 次 ( 公 報 ) \*\*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:1

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl. )	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
1	特公平07-083136	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-045983	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
2	特公平08-008217	H01L 21/205 H01L 33/00 // H01S 3/18		平03-089840	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
1	特許-2540791	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		平03-357046	p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
2	特許-2556211	H01L 21/205 H01L 21/26		平03-074822	半導体結晶層の成長装置とその成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
3	特許-2560963	H01L 33/00		平05-070873	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
4	特許-2560964	H01L 33/00		平05-070874	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
5	特許-2576819	H01L 33/00		平08-085849	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
6	特許-2591521	H01L 33/00		平08-181595	窒化ガリウム系化合物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
7	特許-2628404	C30B 25/14 C30B 29/38 H01L 21/205		平02-288665	半導体結晶膜の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
8	特許-2632239	C30B 25/16 // H01L 21/205		平02-296897	半導体結晶膜の成長方法および装置	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
9	特許-2687742	H01L 21/66 G01N 21/00 H01L 21/205		平03-035460	半導体結晶膜の表面状態測定方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
10	特許-2697572	H01L 33/00 H01L 21/324		平05-234684	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
11	特許-2713094	H01L 33/00		平05-114543	半導体発光素子およびその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
12	特許-2713095	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-114544	半導体発光素子およびその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
13	特許-2728190	H01S 3/18 H01L 23/36 H01L 33/00		平05-042126	半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
14	特許-2735057	H01L 33/00 H01S 3/18		平07-322924	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
15	特許-2748354	H01L 21/301 H01L 21/205 H01L 33/00		平05-263782	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
16	特許-2748355	H01L 21/301 H01L 33/00		平05-279546	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
17	特許-2748818	H01L 33/00		平05-129313	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
18	特許-2751963	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 29/205 H01S 3/18		平05-106555	窒化インジウムガリウム 半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
19	特許-2751987	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 3/18		平05-106557	窒化インジウムガリウム 半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
20	特許-2770717	H01L 33/00		平05-234685	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
21	特許-2770720	H01L 33/00		平05-253171	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
22	特許-2778349	H01L 33/00		平04-118227	窒化ガリウム系化合物半 導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
23	特許-2778405	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-079046	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
24	特許-2780618	H01L 33/00 H01L 21/301 H01L 21/86		平05-300940	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
25	特許-2780691	H01L 33/00 H01S 3/18		平07-314339	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
26	特許-2783349	H01L 33/00		平05-207274	n型窒化ガリウム系化合 物半導体層の電極及びそ の形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
27	特許-2785253	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 3/18		平05-085491	窒化ガリウム系化合物半 導体の p 型化方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
28	特許-2785254	H01L 33/00		平05-157219	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
29	特許-2790235	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		平05-124889	窒化ガリウム系化合物半 導体の p 型化方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
30	特許-2790237	H01L 33/00		平05-157218	多色発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
31	特許-2790242	H01L 33/00		平07-229080	窒化物半導体発光ダイオ ード	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
32	特許-2791448	H01L 33/00		平03-116912	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業 株式会社	3
33	特許-2795294	H01L 33/00 H01L 21/203 H01L 21/205 H01S 3/18		平03-292304	窒化ガリウムアルミニウ ム半導体の結晶成長方法 。	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
34	特許-2800666	H01S 3/18 H01L 33/00		平05-318275	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザー素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
35	特許-2803741	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-085492	窒化ガリウム系化合物半 導体の電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
36	特許-2803742	H01L 33/00 H01L 21/324		平05-124890	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子及びその電 極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
37	特許-2809045	H01L 33/00		平05-114542	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
38	特許-2812375	H01L 33/00 // H01S 3/18		平04-034133	窒化ガリウム系化合物半 導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
39	特許-2827794	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-042125	p 型窒化ガリウムの成長 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
40	特許-2828187	H01L 33/00		平05-107664	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
41	特許-2836685	H01L 33/00		平05-039359	p 型窒化ガリウム系化合 物半導体の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
42	特許-2836686	H01L 33/00		平05-098621	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
43	特許-2836687	H01L 33/00		平05-100215	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
44	特許-2859478	H01L 21/301 H01L 27/12 H01L 33/00		平03-352259	発光デバイス用の窒化ガ リウム系化合物半導体ウ エハーの切断方法	徳 島	日亜化学工業 株式会社	4
45	特許-2861991	H01L 33/00 H01L 21/301 H01L 21/86 H01S 3/18		平09-306394	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
46	特許-2868081	H01L 33/00		平08-267857	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
47	特許-2890390	H01L 33/00 H01S 3/18		平06-154708	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
48	特許-2890392	H01L 33/00 H01S 3/18		平06-269279	I I I - V 族窒化物半導 体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
49	特許-2890396	H01L 33/00 H01S 3/18		平07-317848	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
50	特許-2891348	H01S 3/18		平07-332056	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
51	特許-2900928	H01L 33/00		平09-306393	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
52	特許-2900990	H01S 3/18 H01L 33/00		平07-305281	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
53	特許-2910023	H01L 33/00		平05-327762	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
54	特許-2910811	H01L 33/00 H01L 21/301 H01L 21/304 H01S 3/18	301	平05-092403	窒化ガリウム系化合物半 導体ウエハーの切断方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
55	特許-2914014	H01L 33/00 H01L 21/301		平04-172042	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
56	特許-2914065	H01L 33/00 H01L 23/29 H01L 23/31		平04-351947	青色発光素子及びその製 造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4

\*\* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \*\*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:6

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
57	特許-2917742	H01L 33/00 H01S 3/18 H01S 3/18	673 677	平05-114541	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子とその製造 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
58	特許-2918139	H01L 33/00 H01S 3/18	673	平05-146383	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
59	特許-2921746	H01S 3/18	660	平07-317846	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
60	特許-2932467	H01L 33/00		平05-079045	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
61	特許-2932468	H01L 33/00		平05-310533	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
62	特許-2947047	H01L 21/52		平06-022672	LEDチップのリードフ レームへのダイボン ド方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
63	特許-2953326	H01S 3/18	640	平06-295433	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子の製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
64	特許-2956489	H01L 33/00 H01S 3/18	673	平06-227679	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
65	特許-2964822	H01L 33/00		平05-055074	発光ダイオードの製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
66	特許-2976951	H01L 33/00 H01S 3/18	677	平09-294191	窒化物半導体発光ダイオ ードを備えた表示装置	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
67	特許-2982553	H01L 33/00		平05-109985	発光デバイスの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
68	特許-2985908	H01L 33/00		平03-292303	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
69	特許-2998696	H01L 33/00		平09-143157	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
70	特許-3009091	H01L 33/00		平06-280732	青色発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
71	特許-3009095	H01L 33/00 H01L 21/203		平07-279967	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
72	特許-3019132	H01L 31/10 H01L 31/04		平06-078294	窒化ガリウム系化合物半 導体受光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
73	特許-3036465	G09F 9/33 H01L 33/00 H04N 5/66	103	平09-143159	発光ダイオードを用いた ディスプレイ	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
74	特許-3047960	H01L 29/43 H01L 31/10 H01L 33/00 H01S 5/30		平07-224913	n型窒化物半導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
75	特許-3077781	H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/30		平04-352944	窒化インジウムガリウムの成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
76	特許-3087829	H01L 33/00 H01S 5/323	610	平08-270375	窒化物半導体素子の製造 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
77	特許-3087831	H01L 33/00 H01L 31/10 H01S 5/022		平08-315816	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
78	特許-3091593	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/02		平05-022085	窒化物半導体発光デバイス用積層体	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
79	特許-3101997	H01S 5/10 H01S 5/028	610	平08-018707	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
80	特許-3129384	H01S 5/323 H01S 5/042		平07-020420	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
81	特許-3135041	H01L 33/00		平07-317849	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
82	特許-3141824	H01L 33/00 H01S 5/343	610	平09-286732	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
83	特許-3152238	H01L 33/00		2000-215237	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
84	特許-3154364	H01L 21/60 H01L 33/00 H01S 5/00		平06-008727	n型窒化ガリウム系化合物半導体層の電極及びその形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
85	特許-3180710	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 5/323 // H01L 21/205	610	平09-098493	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
86	特許-3180871	H01L 33/00 H01S 5/042	610	平06-302586	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子およびその 電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
87	特許-3187284	H01L 33/00		平07-157256	n型窒化物半導体層の電 極	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
88	特許-3203282	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-106554	発光デバイス用窒化イン ジウムガリウム半導体	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
89	特許-3209233	H01L 33/00		平04-034234	青色発光ダイオードおよ びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
90	特許-3212008	H01S 5/183		平06-131530	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
91	特許-3216118	H01L 33/00 H01S 5/323		平09-056046	窒化物半導体素子及びそ の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
92	特許-3216596	H01L 33/00		平10-002546	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
93	特許-3218595	H01S 5/227		平08-155370	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
94	特許-3218963	H01S 5/10 H01L 33/00		平08-012796	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
95	特許-3220977	H01S 5/183		平09-116613	窒化物半導体レーザ素子 及び窒化物半導体レーザ 素子の製造方法。	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
96	特許-3223810	H01L 33/00	平08-267856	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6	
97	特許-3223832	H01S 5/323 H01L 33/00	610 平09-056870	窒化物半導体素子及び半 導体レーザダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	11	
98	特許-3224020	H01S 5/22 H01L 33/00	平09-159341	窒化物半導体発光素子お よびその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6	
99	特許-3227287	H01L 33/00 H01L 21/301	平05-288365	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法と 窒化ガリウム系化合物半 導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6	



No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
100	特許-3233258	H01L 33/00 H01S 5/042	612	平08-102542	窒化物半導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
101	特許-3235440	H01S 5/323 H01L 21/20 H01L 21/203 H01L 21/205 H01L 33/00	610	平07-305279	窒化物半導体レーザ素子 とその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
102	特許-3241250	H01S 5/20 H01L 33/00		平07-317845	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
103	特許-3248564	H01S 5/042 H01L 33/00 H01S 5/323	612 610	平09-086536	窒化物半導体レーザダイ オード	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
104	特許-3255224	H01L 33/00		平09-138228	窒化ガリウム系化合物半 導体素子及びその製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
105	特許-3257344	H01L 33/00 C23C 16/18 H01L 21/205 H01S 5/323	610	平07-152676	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
106	特許-3257498	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323	610	平10-029224	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
107	特許-3259811	H01S 5/22 H01L 21/02 H01L 33/00		平07-148470	窒化物半導体素子の製造 方法及び窒化物半導体素 子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
108	特許-3267250	H01L 33/00 H01S 5/323	610	平10-330858	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
109	特許-3269070	H01L 33/00		平07-281170	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
110	特許-3271645	H01L 33/00		平07-140967	窒化物半導体発光ダイオ ード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
111	特許-3271657	H01L 33/00		平09-277251	n型窒化ガリウム系化合 物半導体の電極及びその 形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
112	特許-3272588	H01S 5/323		平07-317847	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

\* \* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \* \*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:10

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
113	特許-3274907	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-106556	窒化インジウムガリウム 化合物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
114	特許-3275810	H01L 33/00 H01S 5/323	610	平09-348973	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
115	特許-3278108	H01S 5/22 H01S 5/323	610	平09-153814	窒化物半導体レーザ素の 製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
116	特許-3282174	H01S 5/323 H01L 31/0264 H01L 31/04 H01L 33/00	610	平09-015171	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
117	特許-3282175	H01S 5/323 H01L 31/10 H01L 33/00	610	平09-021557	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
118	特許-3292083	H01S 5/323 H01L 33/00 // H01L 21/02 H01L 21/205		平09-056047	窒化物半導体基板の製造 方法及び窒化物半導体素 子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
119	特許-3298390	H01L 33/00		平07-321755	窒化物半導体多色発光素 子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
120	特許-3298454	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 5/323 // H01L 21/205	610	平09-098497	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
121	特許-3301345	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 5/323 // H01L 21/205	610	平09-098499	p型窒化ガリウム系化合 物半導体層の形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
122	特許-3301601	H01L 33/00 H01S 5/183		平10-013867	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
123	特許-3303645	H01S 5/323	610	平08-006300	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
124	特許-3307218	H01S 5/22 H01L 33/00		平08-053429	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6

\* \* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \* \*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:11

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
125	特許-3309953	H01S 5/323	610	平09-036791	窒化物半導体レーザダイ オード	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
126	特許-3314620	H01S 5/343 H01L 33/00	610	平08-181573	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
127	特許-3314641	H01S 5/042 H01L 33/00 H01S 5/323	612  610	平08-319067	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
128	特許-3314666	H01L 33/00		平09-151800	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
129	特許-3314671	H01L 33/00		平09-187070	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
130	特許-3319585	H01S 5/02		平10-168872	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
131	特許-3327170	H01L 33/00 G09F 9/00 H01L 21/56 H01L 23/28 H01L 23/29 (以下省略)	336	平09-143158	発光ダイオードの製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
132	特許-3327179	H01S 5/02		平09-232349	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
133	特許-3329753	H01S 5/323	610	平10-355187	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
134	特許-3334624	H01S 5/323	610	平10-173643	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
135	特許-3336599	H01S 5/343 H01S 5/223	610	平08-053428	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
136	特許-3339049	H01S 5/20		平10-199964	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
137	特許-3344056	H01L 33/00 H01L 27/12 H01S 5/042	612	平06-014569	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子及びその製 造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
138	特許-3344414	H01L 33/00		2000-215236	発光ダイオードを用いた ディスプレイ	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
139	特許-3346735	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323	610	平10-049906	窒化物半導体発光素子及 びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	13

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
140	特許-3360812	H01S 5/042 H01L 33/00 H01S 5/343	612  610	平10-144502	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
141	特許-3366188	H01S 5/343 H01L 33/00		平08-149183	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
142	特許-3366586	H01L 33/00		平10-377128	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
143	特許-3369089	H01L 33/00		平09-330959	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
144	特許-3371830	H01S 5/323 H01L 33/00	610	平10-337197	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
145	特許-3372226	H01S 5/343 H01L 33/00	610	平11-256452	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
146	特許-3374737	H01S 5/323 H01L 33/00	610	平09-364012	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	20
147	特許-3379619	H01S 5/343 H01S 5/227	610	平08-041793	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
148	特許-3395631	H01S 5/10 H01L 33/00		平10-050859	窒化物半導体素子及び窒 化物半導体素子の製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
149	特許-3405334	H01S 5/343 H01L 33/00		2000-330288	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
150	特許-3424465	H01S 5/323 H01L 33/00	610	平08-304259	窒化物半導体素子及び窒 化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
151	特許-3431389	H01S 5/22		平08-067632	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
152	特許-3433730	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/343		2000-309753	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	22
153	特許-3434162	H01S 5/02 H01L 33/00		平09-051232	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
154	特許-3438675	H01L 21/205 C30B 29/40 H01S 5/323	502 610	平11-301585	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	14

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
155	特許-3441883	H01S 5/20 H01L 33/00 H01S 5/34		平08-095161	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
156	特許-3448196	H01L 33/00 H01S 5/343	610	平09-348972	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
157	特許-3454355	H01L 33/00 H01L 21/301 H01S 5/02 H01S 5/323		2000-304615	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
158	特許-3456413	H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/30		平10-132831	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
159	特許-3460581	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323	610	平10-146431	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	12
160	特許-3468082	H01S 5/343 H01L 33/00	610	平10-045665	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
161	特許-3470712	H01S 5/223 H01S 5/323		2001-273293	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
162	特許-3473595	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323	610	2001-171341	発光デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
163	特許-3476636	H01S 5/10		平08-333884	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
164	特許-3478090	H01S 5/323	610	平09-311272	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	22
165	特許-3478287	H01S 5/323 C30B 29/38 H01L 33/00	610	2001-266561	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法と窒 化ガリウム系化合物半導 体	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
166	特許-3482955	H01L 33/00 H01S 5/042	610	2000-381850	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
167	特許-3484842	H01S 5/343 H01L 33/00	610	平07-275220	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4

\*\* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \*\*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:14

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
168	特許-3484997	H01L 33/00 H01S 5/20 H01S 5/323	610 610	平10-326404	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
169	特許-3496480	H01S 5/20 H01L 33/00		平09-285404	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
170	特許-3496512	H01L 33/00 H01S 5/026		平10-126989	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
171	特許-3502527	H01S 5/343		平09-106873	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
172	特許-3505167	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 5/323	610	2002-040852	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
173	特許-3511970	H01L 33/00		2000-067673	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
174	特許-3523700	H01S 5/30 H01L 33/00		平07-003033	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
175	特許-3529286	H01S 5/30		平10-335425	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
176	特許-3537977	H01S 5/30 H01L 33/00		平08-349418	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
177	特許-3537984	H01S 5/02 H01L 33/00		平09-044176	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
178	特許-3538275	H01L 33/00		平08-036250	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	24
179	特許-3548442	H01L 33/00 H01S 5/32		平10-329384	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
180	特許-3551751	H01L 21/205		平10-052993	窒化物半導体の成長方法	徳島	日亜化学工業株式会社	14
181	特許-3557894	H01L 33/00 H01S 5/323	610	平10-067553	窒化物半導体基板および 窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
182	特許-3562455	H01S 5/22 H01S 5/323		2000-281097	窒化物半導体レーザ素子 の形成方法	徳島	日亜化学工業株式会社	10
183	特許-3565202	H01S 5/028 H01S 5/02 H01S 5/323	610	2001-361772	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	9

\*\* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \*\*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:15

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
184	特許-3593952	H01S 5/323		2000-158368	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	16
185	特許-3604205	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/30		平07-237501	窒化物半導体の成長方法	徳島	日亜化学工業株式会社	7
186	特許-3604278	H01S 5/22 H01S 5/323		平10-126549	窒化物半導体レーザー素子	徳島	日亜化学工業株式会社	14
187	特許-3617565	H01S 5/30 H01S 5/024		平08-028840	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	7
188	特許-3620292	H01L 33/00 H01S 5/20		平10-176623	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	17
189	特許-3622045	H01S 5/223		平10-008244	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	11
190	特許-3645207	H01L 33/00		2001-313286	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
191	特許-3646649	H01L 33/00 H01S 5/323	610	2000-384363	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
192	特許-3647236	H01S 5/30 H01L 33/00		平09-352540	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
193	特許-3651260	H01L 33/00 H01S 5/343	610	平10-128409	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	17
194	特許-3656454	H01S 5/22 H01S 5/323	610	平11-095129	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
195	特許-3657795	H01L 33/00 H01S 5/30		平11-009276	発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	31
196	特許-3658112	H01S 5/30 H01L 33/00		平08-290218	窒化物半導体レーザダイ オード	徳島	日亜化学工業株式会社	18
197	特許-3658892	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324 H01L 31/04		平08-313442	p型窒化物半導体の成長 方法及び窒化物半導体素 子	徳島	日亜化学工業株式会社	9
198	特許-3659050	H01S 5/323 H01L 33/00	610	平11-037827	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	20

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
199	特許-3660446	H01S 5/30 H01L 33/00		平08-294711	窒化物半導体素子及びその製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	14
200	特許-3669848	H01S 5/343		平10-278308	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	15
201	特許-3679626	H01L 33/00		平10-279386	窒化ガリウム系化合物半導体チップ	徳島	日亜化学工業株式会社	7
202	特許-3685682	H01S 5/22 H01S 5/323		2000-099796	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	23
203	特許-3705047	H01S 5/343 H01L 33/00		平11-308964	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	19
204	特許-3724490	H01L 33/00		2004-011214	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	5
205	特許-3724498	H01L 33/00		2004-280288	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	5
206	特許-3744211	H01S 5/323 H01L 33/00		平10-199829	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	17
207	特許-3758562	H01L 33/00		2001-361771	窒化物半導体多色発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
208	特許-3767491	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323		2002-034089	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
209	特許-3767534	H01L 33/00		2002-244428	発光デバイス	徳島	日亜化学工業株式会社	7
210	特許-3770014	H01L 33/00 H01L 21/20 H01S 5/343 //H01L 21/205		平11-331797	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
211	特許-3772651	H01S 5/22 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/343		2000-222080	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
212	特許-3772807	H01L 33/00		2002-245672	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8
213	特許-3775259	H01S 5/343 H01L 21/20		2001-233486	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11



\*\* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \*\*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:17

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
214	特許-3786000	H01S 5/323		2001-381604	窒化物半導体レーザダイ オードとその製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	8
215	特許-3794530	H01S 5/343 H01L 33/00		平10-367945	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	17
216	特許-3800146	H01S 5/343 H01L 21/205 H01L 21/316 H01L 21/318 H01L 33/00 (以下省略)		2002-229368	窒化物半導体素子の製造 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	15
217	特許-3801353	H01S 5/323 H01L 33/00		平10-139495	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
218	特許-3808892	H01L 33/00		2005-158166	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	5
219	特許-3809749	H01L 33/00		平11-300983	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8
220	特許-3835225	H01L 33/00 H01S 5/343		2001-282288	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	33
221	特許-3835384	H01S 5/343 H01L 33/00		2002-268261	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	28
222	特許-3835446	H01L 33/00 H01S 5/343		2003-355406	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	36
223	特許-3847000	H01L 21/205		平10-131618	窒化物半導体基板上に活 性層を備えた窒化物半導 体層を有する窒化物半導 体素子及びその成長方法	徳島	日亜化学工業株式会社	13
224	特許-3857417	H01S 5/323 H01L 33/00		平10-129810	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	12
225	特許-3859356	H01S 5/323 H01L 33/00		平10-139496	窒化物半導体素子の製造 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	10
226	特許-3867625	H01S 5/343		2002-170623	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8
227	特許-3876518	H01L 21/205 H01L 31/02 H01L 33/00 H01S 5/323		平10-052573	窒化物半導体基板の製造 方法および窒化物半導体 基板	徳島	日亜化学工業株式会社	12

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
228	特許-3884717	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		2003-064147	窒化ガリウム系化合物半 導体の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	8
229	特許-3885092	H01S 5/323 H01L 33/00		平08-032154	窒化物半導体レーザ素子 およびその共振面の作製 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	11
230	特許-3888036	H01S 5/323 H01L 33/00 H01L 21/20 H01L 21/203 H01L 21/205		2000-184901	n型窒化物半導体の成長 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	8
231	特許-3888170	H01S 5/22 H01S 5/028 H01S 5/323		2002-017613	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8
232	特許-3891108	H01S 5/223		2002-354976	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
233	特許-3893614	H01S 5/042 H01S 5/223 H01S 5/323		2002-240432	窒化物半導体レーザ素子 のストライプ導波路の側 面及び窒化物半導体層の 平面に絶縁性の保護膜を 形成する方法	徳島	日亜化学工業株式会社	14
234	特許-3920296	H01L 33/00		2005-158167	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	5
235	特許-3924973	H01L 33/00		平10-369501	窒化物半導体発光素子の 製造方法および窒化物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	15
236	特許-3928621	H01L 33/00 H01L 21/301		2004-010750	発光素子用ウエハー	徳島	日亜化学工業株式会社	7
237	特許-3938101	H01L 33/00 H01S 5/02		2003-137162	発光素子の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	7
238	特許-3941464	H01L 33/00 H01S 5/042 H01S 5/323		2001-341208	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	9
239	特許-3951973	H01S 5/343		2003-184397	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	12
240	特許-3952079	H01L 33/00		2006-189777	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	15

\*\* 特 許 公 報 目 次 ( 公 報 ) \*\*

< データベース : New C/S 日本特許 D B 発行日 : 昭58/01/01 ~ 平26/07/28 >

作成日 : 2014/07/30 page:19

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
241	特許-3953077	H01L 33/00		2005-209226	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
242	特許-3956753	H01L 33/00 H01S 5/323		2002-118852	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	9
243	特許-3972943	H01L 33/00		2005-209227	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	9
244	特許-3992027	H01S 5/343		2004-204862	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	16
245	特許-3995011	H01L 33/00		2005-317711	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	5
246	特許-4028635	H01S 5/343 H01L 33/00		平10-127997	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	20
247	特許-4032836	H01S 5/02 H01S 5/343		2002-170643	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	9
248	特許-4043087	H01S 5/10 H01L 21/205 H01L 33/00		平10-011590	窒化物半導体素子の製造 方法及び窒化物半導体素 子	徳島	日亜化学工業株式会社	18
249	特許-4046114	H01S 5/323		2004-302800	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	20
250	特許-4053747	H01S 5/323 H01S 5/223		2001-273286	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
251	特許-4072202	H01S 5/343 H01S 5/022 H01S 5/22		2004-042161	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
252	特許-4109297	H01L 33/00		2006-141977	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	5
253	特許-4120698	H01S 5/183 H01S 5/343		2007-151951	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	16
254	特許-4131101	H01L 21/20 C30B 29/38 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/323		2001-363030	窒化物半導体素子の製造 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	13

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
255	特許-4197891	H01S 5/223 H01L 21/205 H01S 5/323		2002-154620	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
256	特許-4239444	H01S 5/343		2001-230551	窒化物半導体レーザダイ オード	徳島	日亜化学工業株式会社	18
257	特許-4254373	H01S 5/343		2003-179030	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
258	特許-4277283	H01S 5/343 H01L 33/00		2005-042522	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	20
259	特許-4285337	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		2004-169260	窒化ガリウム系化合物半 導体ウエハーの製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	8
260	特許-4293061	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		2004-169261	窒化ガリウム系化合物半 導体のウエハー	徳島	日亜化学工業株式会社	8
261	特許-4314887	H01L 21/205 H01S 5/343		2003-148359	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	14
262	特許-4321295	H01S 5/343 H01S 5/22		2004-042159	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	12
263	特許-4337132	C30B 29/38 C30B 25/18 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/343		2002-373146	窒化物半導体基板及びそ れを用いた窒化物半導体 素子	徳島	日亜化学工業株式会社	15
264	特許-4370751	H01S 5/028 H01S 5/323		2002-040228	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	12
265	特許-4371714	H01L 33/00 H01S 5/042 H01S 5/323		2003-170766	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8
266	特許-4378070	H01L 33/00 H01S 5/343		2002-128255	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	27
267	特許-4430689	H01S 5/00 H01S 5/343		2007-140655	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	10
268	特許-4438274	H01S 5/343		2002-260153	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	26

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
269	特許-4442093	H01L 21/28 H01S 5/323 H01L 33/32		2002-371821	窒化物半導体積層用基板 の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	13
270	特許-4457417	H01S 5/30 H01L 33/44		平10-267759	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	21
271	特許-4486506	H01L 21/205 H01L 21/02		2004-564676	ハイドライド気相成長方 法による転位密度の低い 無極性窒化ガリウムの成 長	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	20
272	特許-4492013	H01L 33/04 H01L 33/32 H01S 5/343		2001-281328	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
273	特許-4524997	H01S 5/323 H01L 21/205		2003-108767	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
274	特許-4605064	H01S 5/343		2006-083230	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
275	特許-4625998	H01S 5/323		平11-212851	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	24
276	特許-4633962	C30B 29/38 H01L 21/02 H01L 21/205 H01S 5/323		2001-149892	窒化物半導体基板の製造 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	6
277	特許-4637503	H01L 21/205 C30B 29/38 H01L 33/32		2004-139815	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	30
278	特許-4639571	H01S 5/22 H01S 5/343		2002-240433	窒化物半導体レーザ素子 およびその製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	15
279	特許-4815734	H01S 5/343		2003-102713	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	23
280	特許-4816434	H01L 33/32		2006-333737	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	28
281	特許-4947035	H01S 5/22		2008-283153	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	28

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	特 許 権 者		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 ( 名称 )	
282	特許-4954407	H01L 33/06 H01L 33/12 H01L 33/32 H01S 5/323 H01S 5/343		2001-319395	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	12
283	特許-4991025	H01S 5/22 H01S 5/343		2000-099797	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	24
284	特許-5010597	C30B 29/38 C30B 7/10 //H01S 5/323 H01L 33/32		2008-520225	耐圧釜を用いた超臨界ア ンモニア中でのIII族 窒化物結晶の成長方法	米国  埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	15
285	特許-5012629	H01L 21/20 H01L 21/205 H01S 5/22 H01S 5/343		2008-098853	窒化物半導体素子の製造 方法	徳島	日亜化学工業株式会社	14
286	特許-5379973	H01L 33/32 H01L 21/205 H01S 5/343		2007-513224	有機金属気相成長法によ る非極性窒化インジウム ガリウム薄膜、ヘテロ構 造物およびデバイスの製 作	米国  埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	21